ISOS141-SEP 抗辐射高速四通道数字隔离器

1 特性

- 抗辐射
  - 电离辐射总剂量 (TID) 特征值（无 ELDRS）= 30krad(Si)
  - TID RLAT/RHA = 30krad(Si)
  - 125℃ 环境温度下，单粒子锁定（SEL）抗扰度达 LET = 43MeV-cm^2/mg
  - 单粒子绝缘击穿 (SEDR) 在 500V$_{DC}$ 下的抗扰度 (43MeV·cm^2/mg)
- 增强型航天塑料（航天 EP）
  - 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
  - 供应商项目图 (VID) V62/21610
  - 军用级温度范围（-55°C 至 125°C）
  - 同一晶圆制造场所
  - 同一封装测试厂
  - 金键合线，NiPdAu 铅涂层
  - 晶圆批次可追溯性
  - 延长的产品生命周期
  - 延长了产品变更通知周期
- 600V$_{RMS}$ 连续工作电压
- 安全相关认证：
  - DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
  - UL 1577 组件认证计划
- 100Mbps 数据速率
- 宽电源电压范围：2.25V 至 5.5V
- 2.25V 至 5.5V 电平转换
- 默认输出*低*
- 低功耗，1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.5mA
- 低传播延迟：典型值为 10.7ns（5V 电源）
- 通道间偏斜小：最大 4ns（5V 电源供电时）
- CMTI 典型值为 ±100kV/μs
- 系统级 ESD、EFT、浪涌和磁抗扰度
- 小型 QSOP (DBQ-16) 封装

2 应用

- 近地轨道 (LEO) 航天应用
- 信号隔离（RS-422、RS-485、CAN、SPI）
- 栅极驱动器隔离或 GaN 直流/直流转换器的隔离式反馈
- 航天级隔离式直流/直流模块
- 航天器电池管理系统 (BMS)
- 卫星推进电源处理单元 (PPU)
- 发射器和着陆器系统
- 通信有效载荷
- 雷达成像有效载荷

3 说明

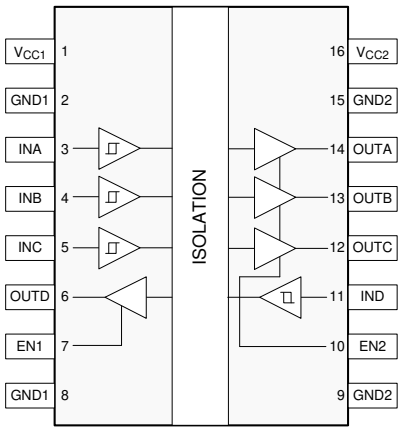
ISOS141-SEP 抗辐射器件是采用小型 16 引脚 QSOP 封装的高性能四通道数字隔离器。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO_2) 绝缘栅相隔离。该器件具有 100Mbps 的高数据速率、10.7ns 的低传播延迟和 4ns 的通道间严格偏移，支持近地轨道 (LEO) 航天应用。ISOS141-SEP 器件具有三个正向通道和一个反向通道，如果失去输入功率或信号，默认输出为低电平。使能引脚可用于将各输出置于高阻抗，适用于多控制器驱动应用，还可降低功耗。

ISOS141-SEP 在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 时，具有高电磁抗扰度和低辐射、低功耗特性。该器件具有 100kV/μs 的高共模瞬态抗扰度，可轻松缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题，还通过出色的芯片设计简化了辐射方面的合规性。

器件信息

器件型号	等级	封装(1)	封装尺寸（标称值）
ISOS141FDBQSEP	30krad(Si) RLAT/RHA	DBQ（QSOP，16）	4.90mm × 3.90mm
ISOS141FDBQTSEP			

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。



V_{CCI} = 输入电源，V_{CC2} = 输出电源
GND1 = 输入接地，GND2 = 输出接地

简化版原理图

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见，TI 提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性，请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本（控制文档）。

内容

1 特性.....1
2 应用.....1
3 说明.....1
4 引脚配置和功能.....3
5 规格.....4
5.1 绝对最大额定值.....4
5.2 ESD 等级.....4
5.3 建议运行条件.....5
5.4 热性能信息.....6
5.5 功率等级.....6
5.6 绝缘规格.....7
5.7 安全相关认证.....8
5.8 安全限值.....8
5.9 电气特性 - 5V 电源.....9
5.10 电源电流特性 - 5V 电源.....9
5.11 电气特性 - 3.3V 电源.....10
5.12 电源电流特性 - 3.3V 电源.....10
5.13 电气特性 - 2.5V 电源.....11
5.14 电源电流特性 - 2.5V 电源.....11
5.15 开关特性 - 5V 电源.....12
5.16 开关特性 - 3.3V 电源.....13
5.17 开关特性 - 2.5V 电源.....14
5.18 绝缘特性曲线.....15
5.19 典型特性.....16
6 工作寿命降额.....17
7 参数测量信息.....18
8 详细说明.....20
8.1 概述.....20
8.2 功能方框图.....20
8.3 特性说明.....21
8.4 器件功能模式.....22
9 应用和实施.....23
9.1 应用信息.....23
9.2 典型应用.....24
9.3 电源相关建议.....28
9.4 布局.....28
10 器件和文档支持.....29
10.1 文档支持.....29
10.2 接收文档更新通知.....29
10.3 支持资源.....29
10.4 商标.....29
10.5 静电放电警告.....29
10.6 术语表.....29
11 修订历史记录.....29
12 机械、封装和可订购信息.....30

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

4 引脚配置和功能

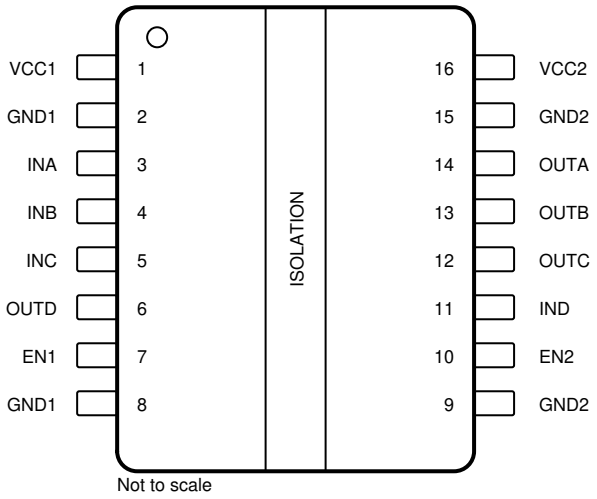


图 4-1. ISOS141-SEP DBQ 封装 16 引脚 QSOP 顶视图

表 4-1. 引脚功能

引脚		类型(1)	说明
名称	编号		
EN1	7	I	输出使能 1。EN1 为高电平或开路时，启用侧 1 的输出引脚，EN1 为低电平时，处于高阻抗状态。
EN2	10	I	输出使能 2。EN2 为高电平或开路时，启用侧 2 的输出引脚，EN2 为低电平时，处于高阻抗状态。
GND1	2 8	—	V_{CC1} 的接地连接
GND2	9 15	—	V_{CC2} 的接地连接
INA	3	I	输入，通道 A
INB	4	I	输入，通道 B
INC	5	I	输入，通道 C
IND	11	I	输入，通道 D
OUTA	14	O	输出，通道 A
OUTB	13	O	输出，通道 B
OUTC	12	O	输出，通道 C
OUTD	6	O	输出，通道 D
V_{CC1}	1	—	电源，侧 1
V_{CC2}	16	—	电源，侧 2

(1) I = 输入；O = 输出

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5 规格

5.1 绝对最大额定值

请参阅(1)

		最小值	最大值	单位
电源电压(2)	V_{CC1}, V_{CC2}	-0.5	6	V
INx、OUTx、ENx 处的电压	V	-0.5	V_{CCX} + 0.5 (3)	V
输出电流	Io	-15	15	mA
温度	工作结温，T_J		150	°C
	存储温度，T_{stg}	-65	150	°C

(1) 超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
(2) 差分 I/O 总线电压以外的所有电压值均为相对于本地接地端子（GND1 或 GND2）的峰值电压值
(3) 最大电压不得超过 6V。

5.2 ESD 等级

			值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模式 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准，所有引脚(1)	±6000	V
		充电器件模型 (CDM)，符合 JEDEC 规范 JESD22-C101，所有引脚(2)	±1500	
		接触放电符合 IEC 61000-4-2 标准；隔离栅耐受测试(3) (4)	±8000	

(1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 能够在标准 ESD 控制流程下安全地进行生产。
(2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
(3) 在隔离栅上施加 IEC ESD 冲击并将两侧的所有引脚都连在一起来构成一个双端子器件。
(4) 在空气或油中进行测试，旨在确定器件的固有接触放电能力。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

			最小值	标称值	最大值	单位
V_{CC1}、V_{CC2} (1)	电源电压		2.25		5.5	V
Vcc (UVLO+)	电源电压上升时的 UVLO 阈值			2	2.25	V
Vcc (UVLO-)	电源电压下降时的 UVLO 阈值		1.7	1.8		V
Vhys (UVLO)	电源电压 UVLO 迟滞		100	200		mV
V_{IH}	高电平输入电压		0.7 × V_{CCI} (2)		V_{CCI}	V
V_{IL}	低电平输入电压		0		0.3 × V_{CCI}	V
I_{OH}	高电平输出电流	V_{CCO} = 5V (2)	-4			mA
		V_{CCO} = 3.3V	-2			mA
		V_{CCO} = 2.5V	-1			mA
I_{OL}	低电平输出电流	V_{CCO} = 5V			4	mA
		V_{CCO} = 3.3V			2	mA
		V_{CCO} = 2.5V			1	mA
DR	数据速率		0		100	Mbps
T_A	环境温度		-55	25	125	°C

(1) V_{CC1} 和 V_{CC2} 可彼此独立设置
(2) V_{CCI} = 输入侧 V_{CC}；V_{CCO} = 输出侧 V_{CC}

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.4 热性能信息

热指标(1)		ISOS141 DBQ (SOIC) 16 引脚	单位
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	109	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳（顶部）热阻	54.4	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	51.9	°C/W
ψ_{JT}	结至顶部特征参数	14.2	°C/W
ψ_{JB}	结至电路板特征参数	51.4	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳（底部）热阻	—	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅*半导体和 IC 封装热指标*应用手册。

5.5 功率等级

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
ISOS141						
P_D	最大功耗（两侧）	V_{CC1} = V_{CC2} = 5.5V，T_J = 150°C，C_L = 15pF，输入 50MHz 50% 占空比方波			200	mW
P_{D1}	最大功耗（1 侧）				75	mW
P_{D2}	最大功耗（2 侧）				125	mW

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.6 绝缘规格

参数		测试条件	值 DBQ-16	单位
CLR	外部间隙(1)	端子间的最短空间距离	>3.7	mm
CPG	外部爬电距离(1)	端子间的最短封装表面距离	>3.7	mm
DTI	绝缘穿透距离	最小内部间隙	>21	um
CTI	相对漏电起痕指数	DIN EN 60112 (VDE 0303-11)；IEC 60112	>600	V
	材料组	符合 IEC 60664-1	I	
	过压类别（符合 IEC 60664-1）	额定市电电压 ≤ 300V_{RMS}	I-III	
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) (2)				
V_{IORM}	最大重复峰值隔离电压	交流电压（双极）	848	V_{PK}
V_{IOWM}	最大工作隔离电压	交流电压；时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试；请参阅图 9-7	600	V_{RMS}
		直流电压	848	V_{DC}
V_{IOTM}	最大瞬态隔离电压	$V_{TEST} = V_{IOTM}$；t = 60s（鉴定测试）；$V_{TEST} = 1.2 \times V_{IOTM}$；t = 1s（100% 生产测试）	4242	V_{PK}
V_{IOSM}	最大浪涌隔离电压(3)	测试方法符合 IEC 62368-1，1.2/50μs 波形	5200	V_{PK}
q_{pd}	视在电荷(4)	方法 a，输入输出安全测试子组 2/3 后，$V_{ini} = V_{IOTM}$，t_{ini} = 60s；$V_{pd(m)} = 1.2 \times V_{IORM}$，$t_m$ = 10s	≤5	pC
		方法 a，环境测试子组 1 后，$V_{ini} = V_{IOTM}$，t_{ini} = 60s；$V_{pd(m)} = 1.2 \times V_{IORM}$，$t_m$ = 10s	≤5	
		常规测试（100% 生产测试）；$V_{ini} = 1.2 \times V_{IOTM}$，$t_{ini}$ = 1s；$V_{pd(m)} = 1.5 \times V_{IORM}$，$t_m$ = 1s（方法 b1）或 $V_{pd(m)} = V_{ini}$，$t_m = t_{ini}$（方法 b2）	≤5	
C_{IO}	势垒电容，输入至输出(5)	V_{IO} = 0.4 × sin (2πft)，f = 1MHz	≅1	pF
R_{IO}	隔离电阻(5)	V_{IO} = 500V，T_A = 25°C	>10^{12}	Ω
		V_{IO} = 500V，100°C ≤ T_A ≤ 125°C	>10^{11}	
		V_{IO} = 500V，T_S = 150°C	>10^9	
	污染等级		2	
	气候类别		55/125/21	
UL 1577				
V_{ISO}	最大耐受隔离电压	$V_{TEST} = V_{ISO}$，t = 60s（鉴定测试）；$V_{TEST} = 1.2 \times V_{ISO}$，t = 1s（100% 生产测试）	3000	V_{RMS}

(1) 爬电距离和间隙应满足应用的特定设备隔离标准中的要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙，从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下，印刷电路板上的爬电距离和间隙变得相等。在印刷电路板上采用插入坡口和/或肋材等技术有助于提高这些规格。
(2) 此耦合器仅适用于安全额定值范围内的*基本电气绝缘*。应借助合适的保护电路来确保符合安全等级。
(3) 在空气或油中执行测试，以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
(4) 视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
(5) 将隔离栅每一侧的所有引脚都连在一起，构成一个双端子器件。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.7 安全相关认证

VDE	UL
根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 进行了认证	根据 UL 1577 组件认证计划进行了认证
基本证书：40047657	文件编号：E181974

5.8 安全限值

安全限值(1)旨在更大限度地减小在发生输入或输出电路故障时对隔离栅的潜在损害。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
DBQ-16 封装						
I_S	安全输入、输出或电源电流	$R_{\theta JA}$ =109°C/W，V_I = 5.5V，T_J = 150°C，T_A = 25°C 参阅图 5-1			209	mA
		$R_{\theta JA}$ = 109°C/W，V_I = 3.6V，T_J = 150°C，T_A = 25°C 参阅 图 5-1			319	mA
		$R_{\theta JA}$ = 109°C/W，V_I = 2.75V，T_J = 150°C，T_A = 25°C 参阅图 5-1			417	
P_S	安全输入、输出或总功率	$R_{\theta JA}$ = 109°C/W，T_J = 150°C，T_A = 25°C， 请参阅图 5-2			1147	mW
T_S	最高安全温度				150	°C

(1) 最高安全温度 T_S 与器件指定的最大结温 T_J 的值相同。I_S 和 P_S 参数分别表示安全电流和安全功率。请勿超出 I_S 和 P_S 的最大限值。这些限值随环境温度 T_A 的变化而变化。
表中的结至空气热阻 $R_{\theta JA}$ 所属器件安装在引线式表面贴装封装对应的高 K 测试板上。可使用以下公式计算各参数值：
$T_J = T_A + R_{\theta JA} \times P$，其中，P 为器件所耗功率。
$T_{J(max)} = T_S = T_A + R_{\theta JA} \times P_S$，其中，$T_{J(max)}$ 为允许的最大结温。
$P_S = I_S \times V_I$，其中，V_I 为最大输入电压。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.9 电气特性 - 5V 电源

V_{CC1} = V_{CC2} = 5V ±10%（在建议运行条件下测得，除非另有说明）

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OH}	高电平输出电压	I_{OH} = -4mA；请参阅图 7-1	V_{CCO} - 0.4 (1)			V
V_{OL}	低电平输出电压	I_{OL} = 4mA；请参阅图 7-1			0.4	V
$V_{IT+(IN)}$	上升输入开关阈值				0.7 x V_{CCI} (1)	V
$V_{IT-(IN)}$	下降输入开关阈值		0.3 x V_{CCI}			V
$V_{I(HYS)}$	输入阈值电压迟滞		0.1 x V_{CCI}			V
I_{IH}	高电平输入电流	在 INx 或 ENx 处，V_{IH} = V_{CCI} (1)			10	µA
I_{IL}	低电平输入电流	在 INx 或 ENx 处，V_{IL} = 0V	-10			µA
CMTI	共模瞬态抗扰度	V_I = V_{CC} 或 0V，V_{CM} = 1200V；请参阅图 7-4	85	100		kV/us
C_i	输入电容 (2)	V_I = V_{CC}/2 + 0.4×sin(2 π ft)，f = 2MHz，V_{CC} = 5V		2		pF

(1) V_{CCI} = 输入侧 V_{CC}；V_{CCO} = 输出侧 V_{CC}
(2) 输入引脚到同侧接地端的测量结果。

5.10 电源电流特性 - 5V 电源

V_{CC1} = V_{CC2} = 5V ±10%（在建议运行条件下测得，除非另有说明）

参数	测试条件		电源电流	最小值	典型值	最大值	单位
ISOS141							
电源电流 - 禁用	EN1 = EN2 = 0V；V_I = 0V (ISOS141)		I_{CC1}		1	1.5	mA
			I_{CC2}		0.8	1.1	
	EN1 = EN2 = 0V；V_I = V_{CCI} (1) (ISOS141)		I_{CC1}		4.3	6.3	
			I_{CC2}		1.8	2.7	
电源电流 - 直流信号 (2)	EN1 = EN2 = V_{CCI}；V_I = 0V (ISOS141)		I_{CC1}		1.5	2.3	
			I_{CC2}		2	3	
	EN1 = EN2 = V_{CCI}；V_I = V_{CCI} (ISOS141)		I_{CC1}		4.8	6.8	
			I_{CC2}		3.2	4.9	
电源电流 - 交流信号 (3)	所有通道均通过方波时钟输入实现开关；C_L = 15pF	1Mbps	I_{CC1}		3.2	4.6	
			I_{CC2}		2.8	4.1	
		10Mbps	I_{CC1}		3.7	5.2	
			I_{CC2}		4.2	5.7	
		100Mbps	I_{CC1}		8.6	11.3	
			I_{CC2}		18	22	

(1) V_{CCI} = 输入侧 V_{CC}
(2) ENx = V_{CCx} 且 ENx = 开路时，电源电流有效
(3) ENx = V_{CCx} 时，电源电流有效

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.11 电气特性 - 3.3V 电源

V_{CC1} = V_{CC2} = 3.3V ±10%（在建议运行条件下测得，除非另有说明）

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OH}	高电平输出电压	I_{OH} = -2mA；请参阅图 7-1	V_{CCO} - 0.3 (1)			V
V_{OL}	低电平输出电压	I_{OL} = 2mA；请参阅图 7-1			0.3	V
$V_{IT+(IN)}$	上升输入开关阈值				0.7 × V_{CCI} (1)	V
$V_{IT-(IN)}$	下降输入开关阈值		0.3 × V_{CCI}			V
$V_{I(HYS)}$	输入阈值电压迟滞		0.1 × V_{CCI}			V
I_{IH}	高电平输入电流	在 INx 或 ENx 处，V_{IH} = V_{CCI} (1)			10	μA
I_{IL}	低电平输入电流	在 INx 或 ENx 处，V_{IL} = 0V	-10			μA
CMTI	共模瞬态抗扰度	V_I = V_{CC} 或 0V，V_{CM} = 1200V；请参阅图 7-4	85	100		kV/μs
C_i	输入电容 (2)	V_I = V_{CC}/2 + 0.4 × sin(2πft)，f = 1MHz，V_{CC} = 5V		2		pF

(1) V_{CCI} = 输入侧 V_{CC}；V_{CCO} = 输出侧 V_{CC}
(2) 输入引脚到同侧接地端的测量结果。

5.12 电源电流特性 - 3.3V 电源

V_{CC1} = V_{CC2} = 3.3V ±10%（在建议运行条件下测得，除非另有说明）

参数	测试条件		电源电流	最小值	典型值	最大值	单位
ISOS141							
电源电流 - 禁用	EN1 = EN2 = 0V；V_I = 0V (ISOS141)		I_{CC1}		1	1.5	mA
			I_{CC2}		0.8	1.1	
	EN1 = EN2 = 0V；V_I = V_{CC1} (1) (ISOS141)		I_{CC1}		4.3	6.3	
			I_{CC2}		1.9	2.7	
电源电流 - 直流信号 (2)	EN1 = EN2 = V_{CCI}；V_I = 0V (ISOS141)		I_{CC1}		1.5	2.3	
			I_{CC2}		2	3	
	EN1 = EN2 = V_{CCI}；V_I = V_{CCI} (ISOS141)		I_{CC1}		4.8	6.8	
			I_{CC2}		3.2	4.9	
电源电流 - 交流信号 (3)	所有通道均通过方波时钟输入实现开关；C_L = 15pF	1Mbps	I_{CC1}		3.2	4.6	
			I_{CC2}		2.7	4.1	
		10Mbps	I_{CC1}		3.5	5	
			I_{CC2}		3.7	5.2	
		100Mbps	I_{CC1}		6.8	9.3	
			I_{CC2}		13.7	16.4	

(1) V_{CCI} = 输入侧 V_{CC}
(2) ENx = V_{CCx} 且 ENx = 开路时，电源电流有效
(3) ENx = V_{CCx} 时，电源电流有效

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.13 电气特性 - 2.5V 电源

V_{CC1} = V_{CC2} = 2.5V ±10%（在建议运行条件下测得，除非另有说明）

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OH}	高电平输出电压	I_{OH} = -1mA；请参阅图 7-1	V_{CCO} - 0.2 (1)			V
V_{OL}	低电平输出电压	I_{OL} = 1mA；请参阅图 7-1			0.2	V
$V_{IT+(IN)}$	上升输入开关阈值				0.7 × V_{CCI} (1)	V
$V_{IT-(IN)}$	下降输入开关阈值		0.3 × V_{CCI}			V
$V_{I(HYS)}$	输入阈值电压迟滞		0.1 × V_{CCI}			V
I_{IH}	高电平输入电流	在 INx 或 ENx 处，V_{IH} = V_{CCI} (1)			10	μA
I_{IL}	低电平输入电流	在 INx 或 ENx 处，V_{IL} = 0V	-10			μA
CMTI	共模瞬态抗扰度	V_I = V_{CC} 或 0V，V_{CM} = 1200V；请参阅图 7-4	85	100		kV/μs
C_i	输入电容 (2)	V_I = V_{CC}/2 + 0.4×sin(2πft)，f = 1MHz，V_{CC} = 5V		2		pF

(1) V_{CCI} = 输入侧 V_{CC}；V_{CCO} = 输出侧 V_{CC}
(2) 输入引脚到同侧接地端的测量结果。

5.14 电源电流特性 - 2.5V 电源

V_{CC1} = V_{CC2} = 2.5V ±10%（在建议运行条件下测得，除非另有说明）

参数	测试条件		电源电流	最小值	典型值	最大值	单位
ISOS141							
电源电流 - 禁用	EN1 = EN2 = 0V；V_I = 0V (ISOS141)		I_{CC1}		1	1.5	mA
			I_{CC2}		0.8	1.1	
	EN1 = EN2 = 0V；V_I = V_{CC1} (1) (ISOS141)		I_{CC1}		4.3	6.3	
			I_{CC2}		1.8	2.7	
电源电流 - 直流信号 (2)	EN1 = EN2 = V_{CCI}；V_I = 0V (ISOS141)		I_{CC1}		1.4	2.3	
			I_{CC2}		2	3	
	EN1 = EN2 = V_{CCI}；V_I = V_{CCI} (ISOS141)		I_{CC1}		4.7	6.8	
			I_{CC2}		3.2	4.9	
电源电流 - 交流信号 (3)	所有通道均通过方波时钟输入实现开关；C_L = 15pF	1Mbps	I_{CC1}		3.1	4.6	
			I_{CC2}		2.7	4	
		10Mbps	I_{CC1}		3.4	4.9	
			I_{CC2}		3.5	4.9	
		100Mbps	I_{CC1}		5.6	8.3	
			I_{CC2}		10.8	13.8	

(1) V_{CCI} = 输入侧 V_{CC}
(2) ENx = V_{CCx} 且 ENx = 开路时，电源电流有效
(3) ENx = V_{CCx} 时，电源电流有效

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.15 开关特性 - 5V 电源

V_{CC1} = V_{CC2} = 5V ±10%（在建议运行条件下测得，除非另有说明）

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
t_{PLH}、t_{PHL}	传播延迟时间	请参阅图 7-1		10.7	16	ns
PWD	脉宽失真(1) $\lvert t_{PHL} - t_{PLH} \rvert$				4.9	ns
$t_{sk(o)}$	通道间输出偏斜时间(2)	同向通道			4	ns
$t_{sk(pp)}$	器件间偏斜时间(3)				4.4	ns
t_r	输出信号上升时间	请参阅图 7-1		2.4	3.9	ns
t_f	输出信号下降时间			2.4	3.9	ns
t_{PHZ}	禁用传播延时，高电平至高阻抗输出	请参阅图 7-2		9	20	ns
t_{PLZ}	禁用传播延时，低电平至高阻抗输出			9	20	ns
t_{PZH}	启用传播延时，高阻抗至高电平输出，适用于带有后缀 F 的 ISOS141			3	8.5	µs
t_{PZL}	启用传播延时，高阻抗至低电平输出，适用于带有后缀 F 的 ISOS141			7	20	ns
t_{DO}	输入功率损耗的默认输出延时时间	从 VCC 低于 1.7V 之时开始测量。请参阅图 7-3		0.1	0.3	µs
t_{ie}	时间间隔误差	100Mbps 时的 PRBS 数据为 2^{16} – 1		0.8		ns

(1) 也称为脉冲偏斜。
(2) $t_{sk(o)}$ 是以下单个器件的输出之间的偏斜：所有驱动输入均连在一起且在驱动相同负载时输出在相同方向上开关。
(3) $t_{sk(pp)}$ 是以下不同器件的任意端子之间的传播延迟时间差幅度：在相同电源电压、温度、输入信号和负载下工作，同时在相同方向上开关。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.16 开关特性 - 3.3V 电源

V_{CC1} = V_{CC2} = 3.3V ±10%（在建议运行条件下测得，除非另有说明）

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
t_{PLH}、t_{PHL}	传播延迟时间	请参阅图 7-1		11	16	ns
PWD	脉宽失真(1) $\lvert t_{PHL} - t_{PLH} \rvert$				5	ns
$t_{sk(o)}$	通道间输出偏斜时间(2)	同向通道			4.1	ns
$t_{sk(pp)}$	器件间偏斜时间(3)				4.5	ns
t_r	输出信号上升时间	请参阅图 7-1		1.3	3	ns
t_f	输出信号下降时间			1.3	3	ns
t_{PHZ}	禁用传播延时，高电平至高阻抗输出	请参阅图 7-2		17	30	ns
t_{PLZ}	禁用传播延时，低电平至高阻抗输出			17	30	ns
t_{PZH}	启用传播延时，高阻抗至高电平输出，适用于带有后缀 F 的 ISOS141			3.2	8.5	µs
t_{PZL}	启用传播延时，高阻抗至低电平输出，适用于带有后缀 F 的 ISOS141			17	30	ns
t_{DO}	输入功率损耗的默认输出延时时间	从 VCC 低于 1.7V 之时开始测量。请参阅图 7-3		0.1	0.3	µs
t_{ie}	时间间隔误差	100Mbps 时的 PRBS 数据为 2^{16} – 1		0.9		ns

(1) 也称为脉冲偏斜。
(2) $t_{sk(o)}$ 是以下单个器件的输出之间的偏斜：所有驱动输入均连在一起且在驱动相同负载时输出在相同方向上开关。
(3) $t_{sk(pp)}$ 是以下不同器件的任意端子之间的传播延迟时间差幅度：在相同电源电压、温度、输入信号和负载下工作，同时在相同方向上开关。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.17 开关特性 - 2.5V 电源

V_{CC1} = V_{CC2} = 2.5V ±10%（在建议运行条件下测得，除非另有说明）

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
t_{PLH}、t_{PHL}	传播延迟时间	请参阅图 7-1		12	18.5	ns
PWD	脉宽失真(1) $\lvert t_{PHL} - t_{PLH} \rvert$				5.1	ns
$t_{sk(o)}$	通道间输出偏斜时间(2)	同向通道			4.1	ns
$t_{sk(pp)}$	器件间偏斜时间(3)				4.6	ns
t_r	输出信号上升时间	请参阅图 7-1		1	3.5	ns
t_f	输出信号下降时间			1	3.5	ns
t_{PHZ}	禁用传播延时，高电平至高阻抗输出	请参阅图 7-2		22	40	ns
t_{PLZ}	禁用传播延时，低电平至高阻抗输出			22	40	ns
t_{PZH}	启用传播延时，高阻抗至高电平输出，适用于带有后缀 F 的 ISOS141			3.3	8.5	µs
t_{PZL}	启用传播延时，高阻抗至低电平输出，适用于带有后缀 F 的 ISOS141			18	40	ns
t_{DO}	输入功率损耗的默认输出延时时间	从 VCC 低于 1.7V 之时开始测量。请参阅图 7-3		0.1	0.3	µs
t_{ie}	时间间隔误差	100Mbps 时的 PRBS 数据为 2^{16} – 1		0.7		ns

(1) 也称为脉冲偏斜。
(2) $t_{sk(o)}$ 是以下单个器件的输出之间的偏斜：所有驱动输入均连在一起且在驱动相同负载时输出在相同方向上开关。
(3) $t_{sk(pp)}$ 是以下不同器件的任意端子之间的传播延迟时间差幅度：在相同电源电压、温度、输入信号和负载下工作，同时在相同方向上开关。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.18 绝缘特性曲线

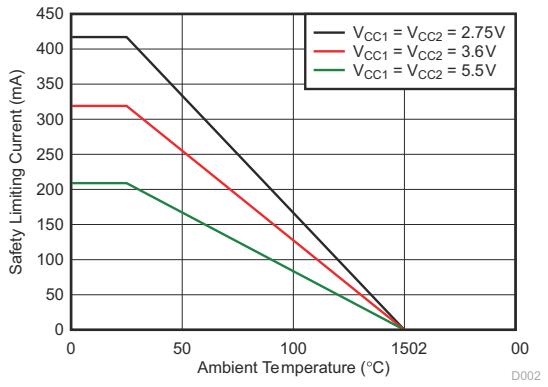


图 5-1. DBQ-16 封装安全限制电流的热降额曲线

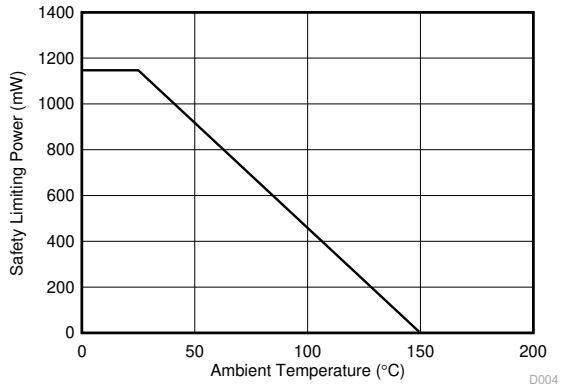
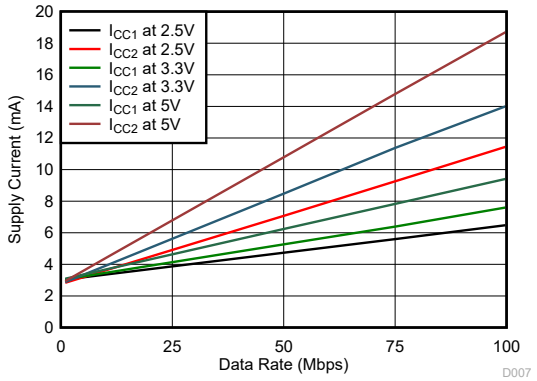


图 5-2. DBQ-16 封装安全限制功率的热降额曲线

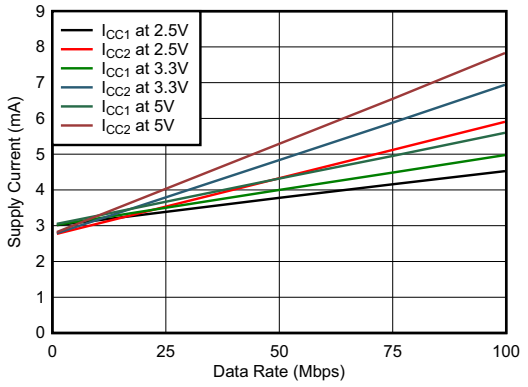
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.19 典型特性



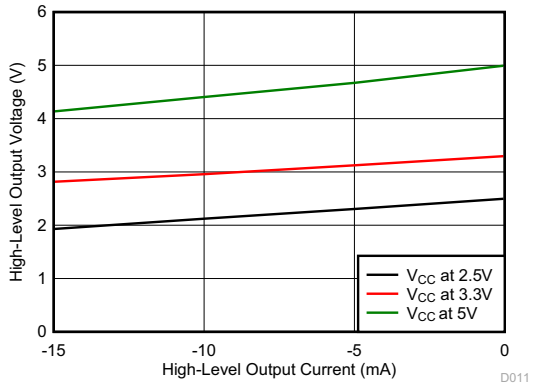
T_A = 25°C C_L = 15pF

图 5-3. 电源电流与数据速率间的关系（具有 15pF 负载）



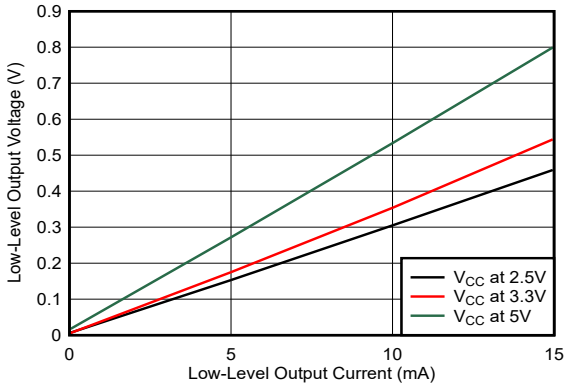
T_A = 25°C C_L = 无负载

图 5-4. 电源电流与数据速率之间的关系（无负载）



T_A = 25°C

图 5-5. 高电平输出电压与高电平输出电流间的关系



T_A = 25°C

图 5-6. 低电平输出电压与低电平输出电流间的关系

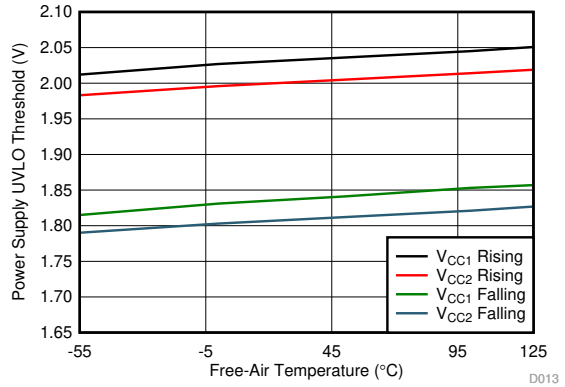


图 5-7. 电源欠压阈值与自然通风条件下的温度间的关系

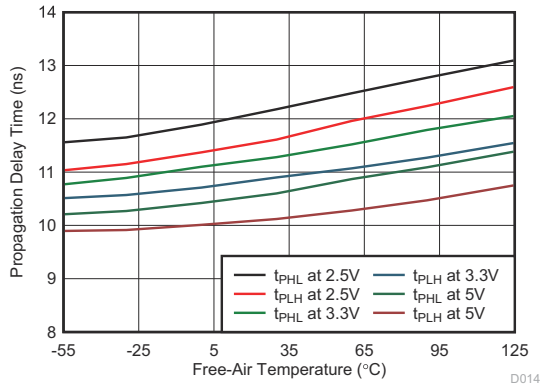
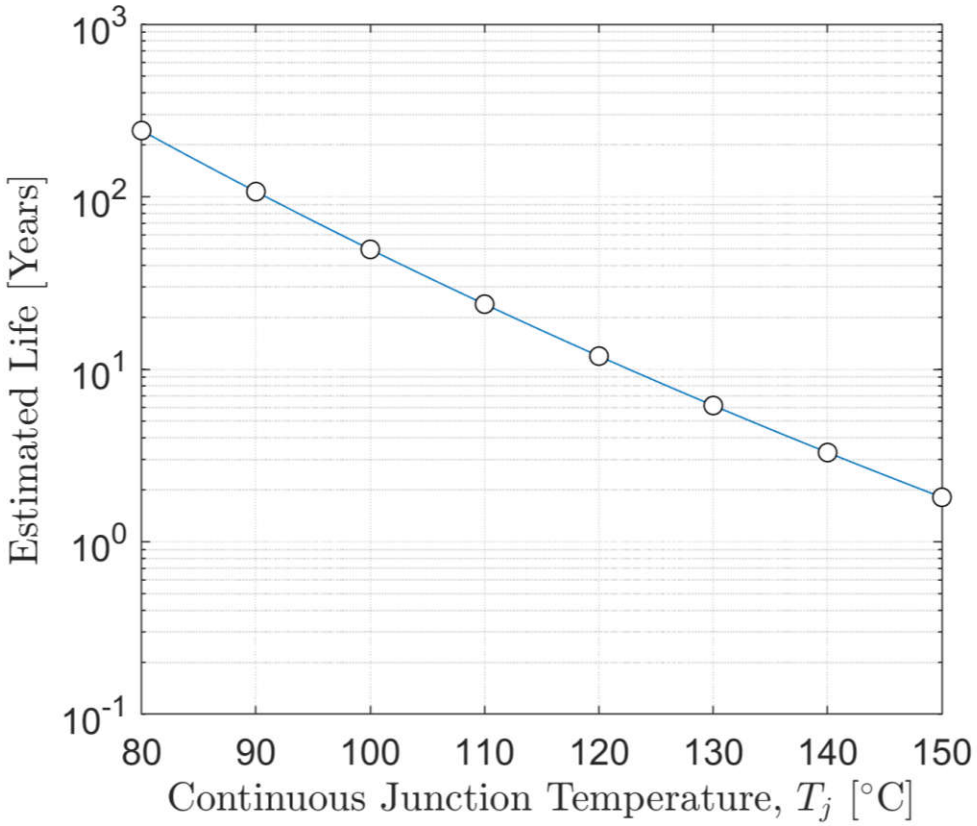


图 5-8. 传播延迟时间与自然通风条件下的温度间的关系

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

6 工作寿命降额

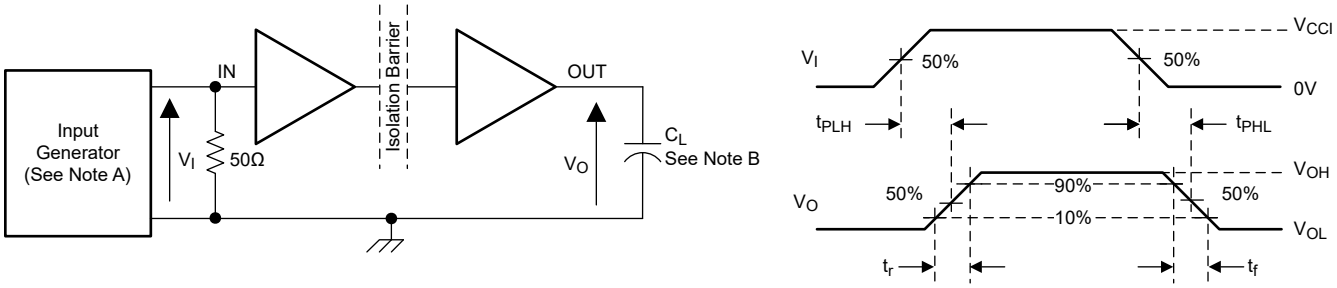
为方便起见，本节单独提供这些信息，并且未扩展或修改适用于 TI 半导体产品的 TI 标准条款和条件下提供的保修范围。



1. 在 105°C 结温条件下，器件使用寿命设计目标为 100000 小时的通电时间 (POH) (不包括封装互连寿命) 。
2. 根据可靠性建模确定预计使用寿命与结温之间的关系，对于特定器件工艺和设计特性，使用键合线寿命作为影响器件磨损的主要故障机制。

键合线寿命降额曲线

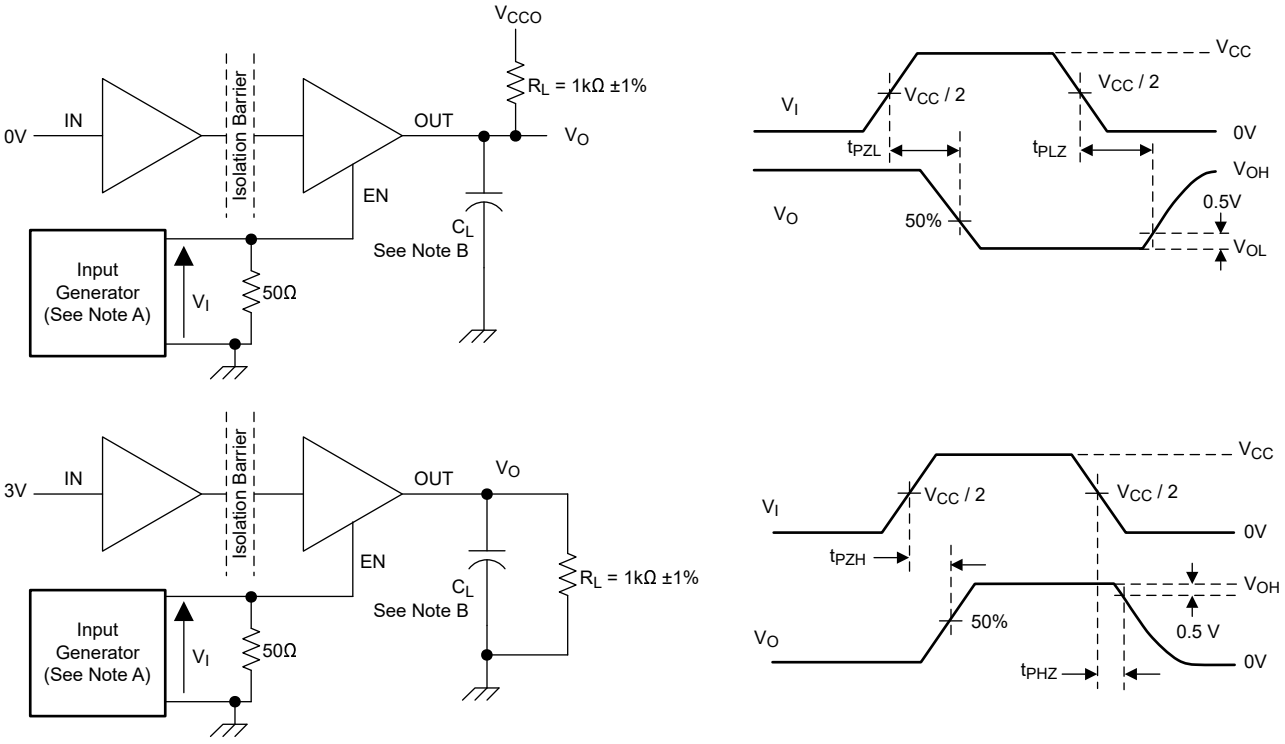
7 参数测量信息



A. 输入脉冲由具有以下特性的发生器提供：PRR ≤ 50kHz，50% 占空比，t_r ≤ 3ns，t_f ≤ 3ns，Z_O = 50 Ω。输入端需要 50 Ω 电阻器来端接输入发生器信号。实际应用中并不需要 50 Ω 电阻器。

B. C_L = 15pF 并包含 ±20% 范围内的仪表和设备电容。

图 7-1. 开关特性测试电路和电压波形

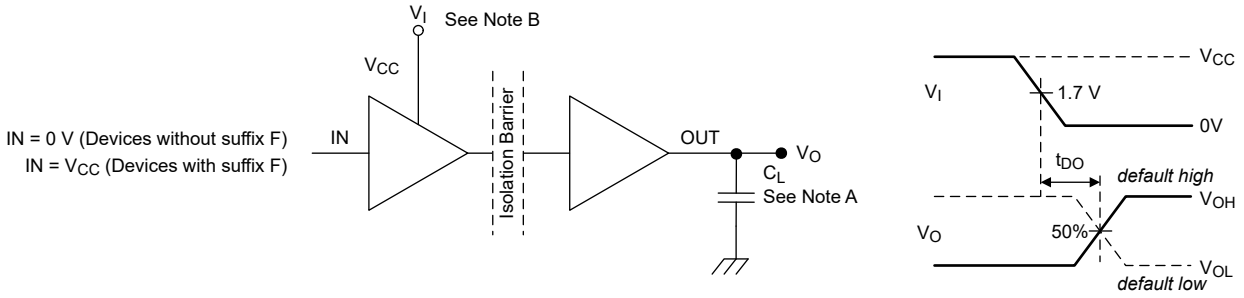


A. 输入脉冲由具有以下特性的发生器提供：PRR ≤ 10kHz，50% 占空比，t_r ≤ 3ns，t_f ≤ 3ns，Z_O = 50 Ω。

B. C_L = 15pF 并包含 ±20% 范围内的仪表和设备电容。

图 7-2. 启用/禁用传播延时时间测试电路和波形

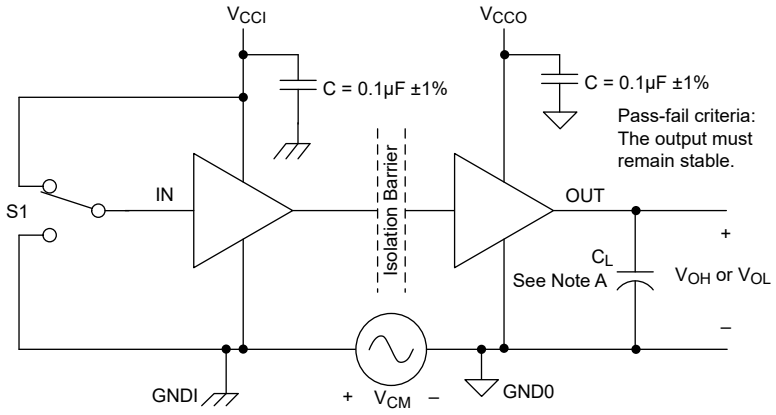
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated



A. C_L = 15pF 并包含 ±20% 范围内的仪表和设备电容。

B. 电源电压斜升速率 = 10mV/ns

图 7-3. 默认输出延时时间测试电路和电压波形



A. C_L = 15pF 并包含 ±20% 范围内的仪表和设备电容。

图 7-4. 共模瞬态抗扰度测试电路

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

8 详细说明

8.1 概述

ISOS141-SEP 采用开关键控 (OOK) 调制方案，以便通过基于二氧化硅的隔离栅传输数字数据。发送器通过隔离栅发送高频载波来表示一种数字状态，而不发送信号则表示另一种数字状态。接收器在高级信号调节后对信号进行解调并通过缓冲器级产生输出。如果 ENx 引脚为低电平，则输出变为高阻抗。ISOS141-SEP 器件还采用了先进的电路技术，可充分提高 CMTI 性能，并有效减少高频载波和 IO 缓冲器开关产生的辐射。图 8-1 为数字电容隔离器的概念方框图，展示了典型通道的功能方框图。

8.2 功能方框图

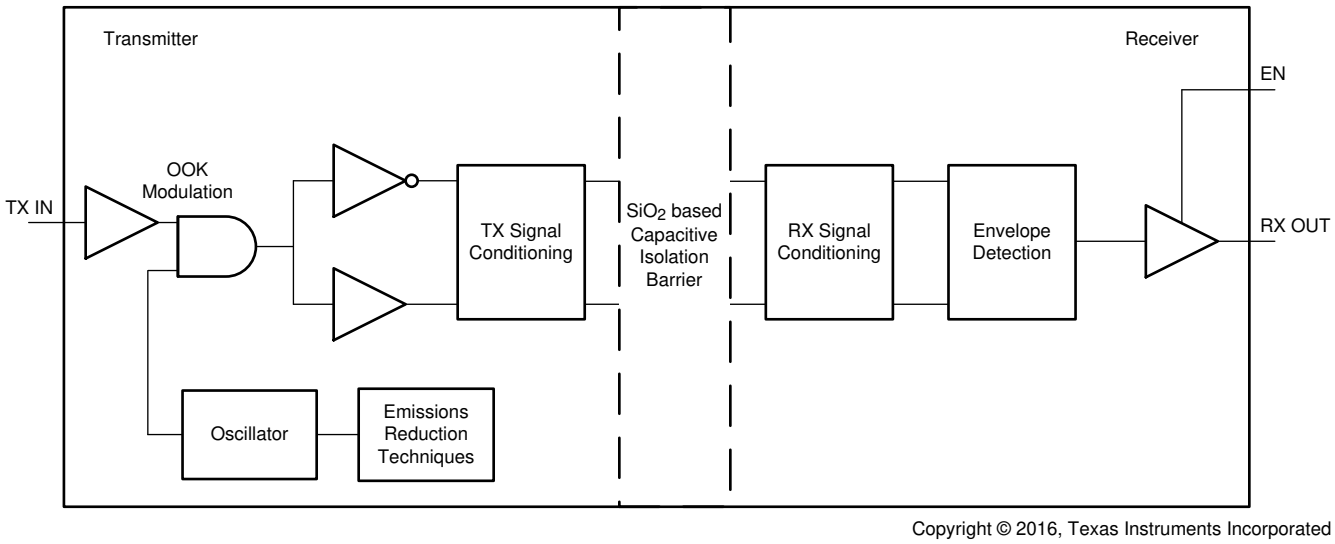


图 8-1. 数字电容隔离器的概念框图

图 8-2 所示为开关键控方案工作原理的概念细节。

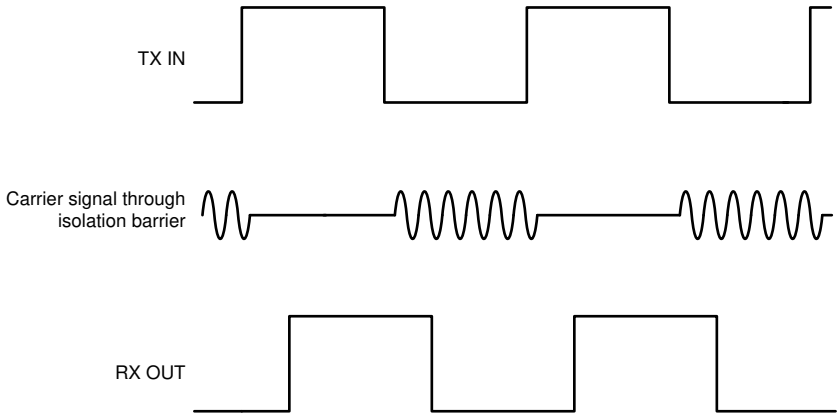


图 8-2. 基于开关键控 (OOK) 的调制方案

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

8.3 特性说明

表 8-1 汇总了器件特性。

表 8-1. 器件特性

器件型号	通道方向	最大数据速率	默认输出	封装	隔离额定值(1)
ISOS141-SEP 带有后缀 F	3 个正向， 1 个反向	100Mbps	低	DBQ-16	$3000V_{RMS}/4242V_{PK}$

(1) 有关详细的隔离等级，请参阅安全相关认证。

8.3.1 辐射耐受性

总电离剂量 (TID) — ISOS141-SEP 是一款抗辐射 TI 增强型航天塑料 (Space EP) 器件，因此该器件在首页的“器件信息”表中指定了总电离剂量 (TID) 水平。根据 MIL-STD-883 测试方法 1019，在晶圆级完成这些产品的测试和鉴定。辐射批次验收测试 (RLAT) 是在 30krad TID 水平下执行的。可提供 TID 特性报告。E 组 TID RLAT 数据可以在批次发货时作为 QCI 摘要报告的一部分提供。

单粒子效应 (SEE) = 一次性 SEE 表征根据 EIA/JEDEC 标准 EIA/JEDEC57 进行，线性能量传递 (LET) = 43MeV·cm^2 /mg。在测试期间，未观察到单粒子闩锁 (SEL) 或单粒子绝缘击穿 (SEDR)。

中子位移损伤 (NDD) — ISOS141-SEP 的辐照度高达 1×10^{12} n/cm^2。根据 MILSTD-883 方法 1017 对中子辐照进行辐射测试，将对规模为 15 个器件的样本进行辐射测试。

辐射测试和表征报告 — 适用于本节中描述的所有辐射效应，要查找最新报告，请访问 TI.com 上的 ISOS141-SEP 技术文档部分。

8.3.2 电磁兼容性 (EMC) 注意事项

恶劣工业环境中的很多应用都对静电放电 (ESD)、电气快速瞬变 (EFT)、浪涌和电磁辐射等干扰非常敏感。尽管系统级性能与可靠性在很大程度上取决于应用电路板的设计和布局，但为了实现整体系统的稳健性，ISOS141-SEP 器件在芯片级设计方面进行了诸多改进。其中的一些改进包括：

- 输入和输出信号引脚以及芯片间接合焊盘具有可靠的 ESD 保护单元。
- ESD 单元与电源和接地引脚之间采用低电阻连接。
- 高压隔离电容器具有增强性能，能够更好地耐受 ESD、EFT 和浪涌事件。
- 片上去耦电容器更大，可通过低阻抗路径旁路不良的高能信号。
- PMOS 和 NMOS 器件通过防护环互相隔离，从而避免触发寄生 SCR。
- 通过提供纯差分内部运行，减少隔离栅上的共模电流。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

8.4 器件功能模式

表 8-2 列出了 ISOS141-SEP 器件的功能模式。

表 8-2. 功能表

V_{CCI} (1)	V_{CCO}	输入 (INx)(3)	输出使能 (ENx)	输出 (OUTx)	注释
PU	PU	H	H 或开路	H	正常运行： 通道输出假定输入的逻辑状态。
		L	H 或开路	L	
		开路	H 或开路	默认值	默认模式：INx 断开时，相应通道输出进入默认逻辑状态。默认为带有后缀 F 的 ISOS141-SEP 的*低电平*。
X	PU	X	L	Z	输出使能值偏低，会导致输出为高阻抗。
PD	PU	X	H 或开路	默认值	默认模式：V_{CCI} 未上电时，通道输出根据所选默认选项假定逻辑状态。默认为带有后缀 F 的 ISOS141-SEP 的*低电平*。 V_{CCI} 从未上电转换为上电时，通道输出假定输入的逻辑状态。 V_{CCI} 从上电转换为未上电时，通道输出假定所选默认状态。
X	PD	X	X	不确定	V_{CCO} 未上电时，通道输出不确定(2)。 V_{CCO} 从未上电转换为上电时，通道输出假定输入的逻辑状态。

(1) V_{CCI} = 输入侧 V_{CC}；V_{CCO} = 输出侧 V_{CC}；PU = 上电 (V_{CC} ≥ 2.25V)；PD = 断电 (V_{CC} ≤ 1.7V)；X = 不相关；H = 高电平；L = 低电平；Z = 高阻抗
(2) 当 1.7V < V_{CCI} 且 V_{CCO} < 2.25V 时，输出为不确定状态。
(3) 强驱动输入信号可通过内部保护二极管为浮动 V_{CC} 提供微弱的电能，导致输出不确定。

8.4.1 *器件 I/O 原理图*

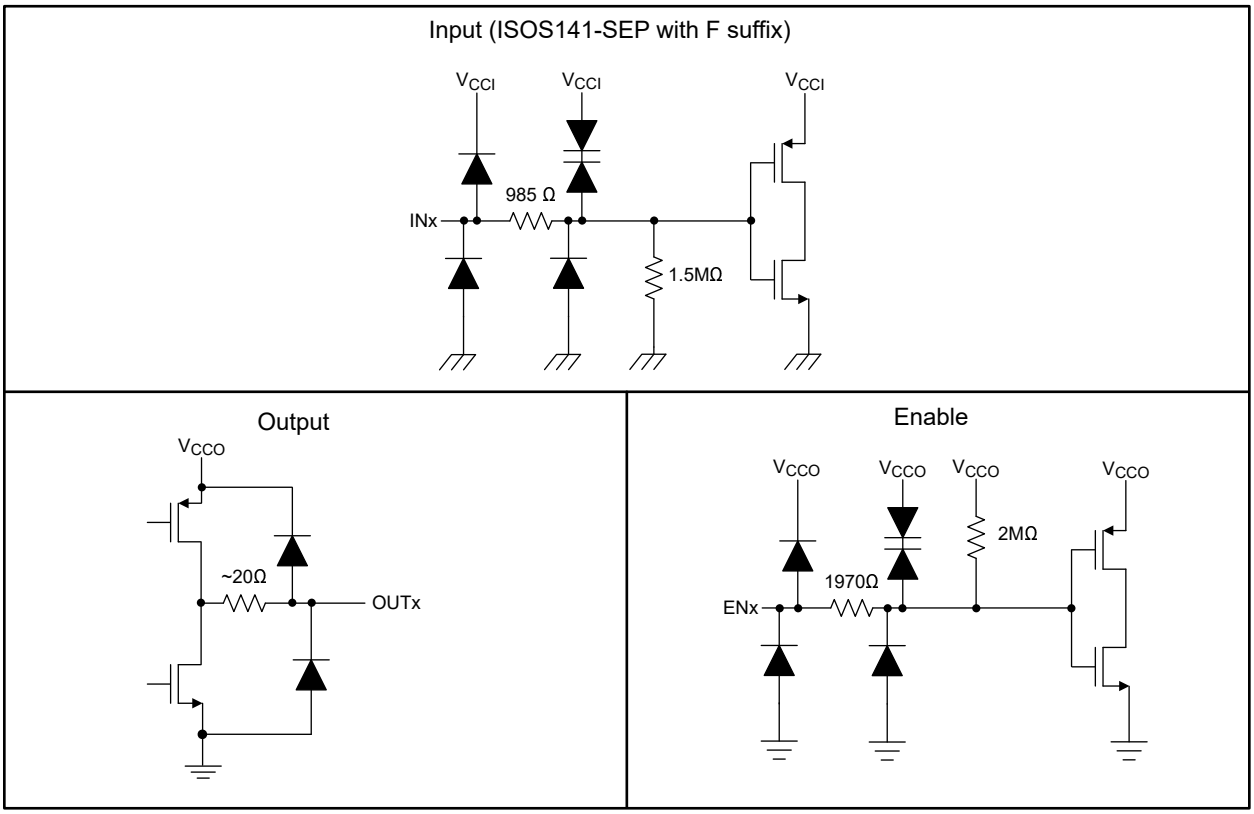


图 8-3. 器件 I/O 原理图

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

9 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定各元件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计是否能够实现，以确保系统功能。

9.1 应用信息

ISOS141-SEP 四通道数字隔离器可以灵活用于 LEO 应用中的多种用例。这些器件与隔离式电源结合使用，有助于防止 UART、SPI、RS-485、RS-232 和 CAN 等数据总线上的噪声电流损坏敏感电路。该器件还可用于隔离系统中的多个静态信号，以提供额外的冗余和稳健性。使用数字隔离器进行设计时，请注意由于采用的是单端设计结构，数字隔离器不符合任何特定的接口标准，并仅用于隔离单端 CMOS 或 TTL 数字信号线。不管接口类型或标准如何，隔离器通常都位于数据控制器（即 MCU 或 FPGA）和数据转换器或数据线收发器之间。

此外，数字隔离器还可用作逻辑电平转换器。隔离栅将两侧分开，因此，在推荐工作条件下，可使用任何电压单独为每一侧供电。V_{CC1} 和 V_{CC2} 这两个电源的电源电压范围均为 2.25V 至 5.5V。例如，可为 ISOS141-SEP V_{CC1} 提供 3.3V 电压（在 2.25V 至 5.5V 范围内），为 V_{CC2} 提供 5V 电压（也在 2.25V 至 5.5V 范围内）。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

9.2 典型应用

图 9-1 展示了 GaN 半桥电路中的 ISOS141-SEP 用于将 PWM 信号从初级侧的半桥控制器隔离到次级侧的半桥栅极驱动器，从而通过同步整流实现更高的效率。

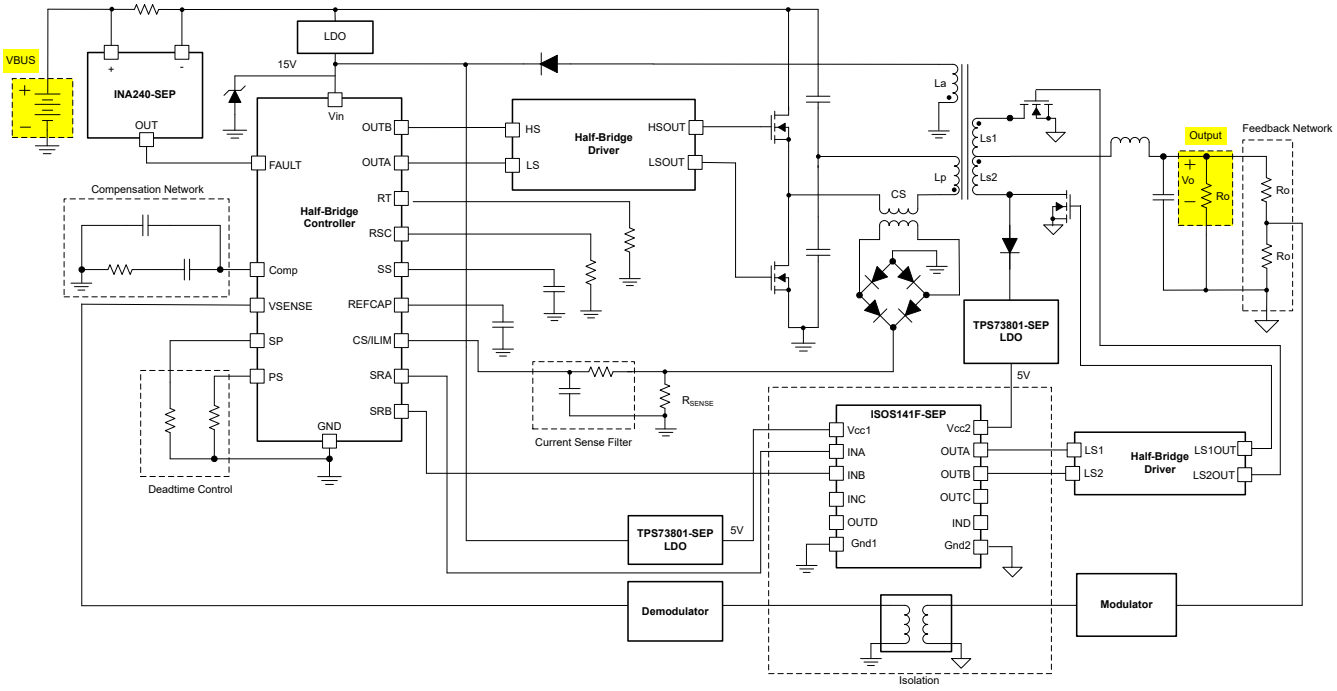


图 9-1. 基于 GaN 的隔离式 75V 至 5V 50W 半桥拓扑

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

9.2.1 设计要求

若要使用这些器件进行设计，请使用表 9-1 中所列参数。

表 9-1. 设计参数

参数	值
电源电压：V_{CC1} 和 V_{CC2}	2.25 至 5.5V
V_{CC1} 和 GND1 之间的去耦电容器	0.1μF
V_{CC2} 和 GND2 之间的去耦电容器	0.1μF

9.2.2 详细设计过程

ISOS141-SEP 器件只需两个外部旁路电容器即可工作。

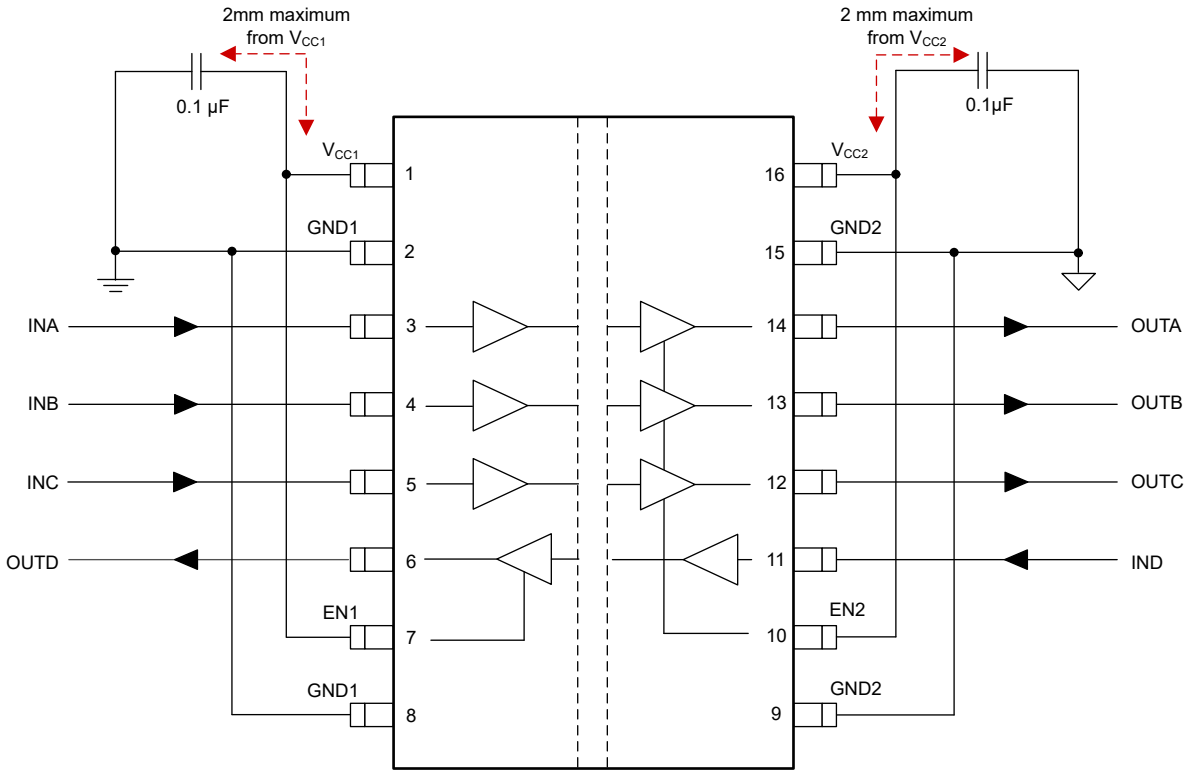


图 9-2. 典型 ISOS141-SEP 电路组装

9.2.3 应用曲线

以下为 ISOS141-SEP 器件的典型眼图，展示了在 100Mbps 最大数据速率下的低抖动和大张开度。

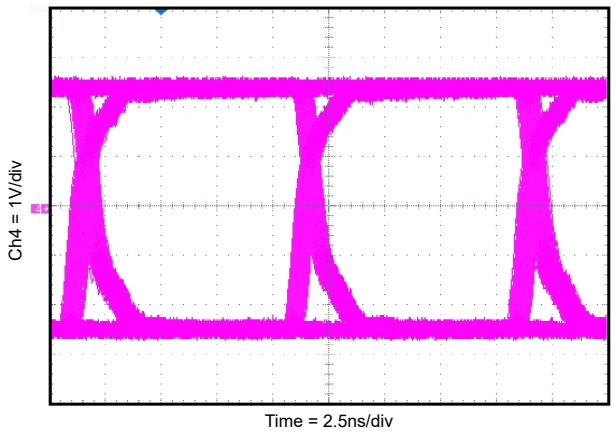


图 9-3. 眼图：100Mbps PRBS 2^{16} – 1，5V，25°C

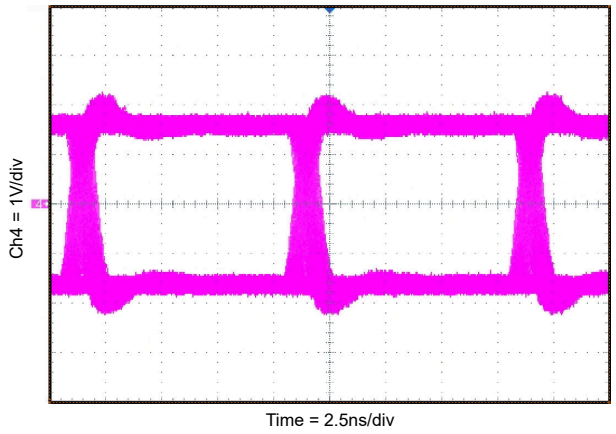


图 9-4. 眼图：100Mbps PRBS 2^{16} – 1，3.3V，25°C

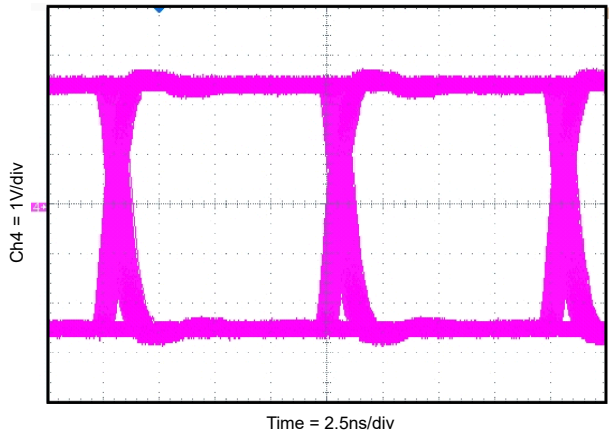


图 9-5. 眼图：100Mbps PRBS 2^{16} – 1，2.5V，25°C

9.2.3.1 绝缘寿命

绝缘寿命预测数据是使用业界通用的时间依赖性电介质击穿 (TDDB) 测试方法收集的。在该测试中，隔离栅两侧的所有引脚都连在一起，构成了一个双端子器件，并在两侧之间施加高电压；对于 TDDB 测试设置，请参阅 图 9-6。绝缘击穿数据是在开关频率为 60Hz 以及各种高电压条件下在整个温度范围内收集的。对于增强型绝缘，VDE 标准要求使用故障率小于 1 ppm 的 TDDB 预测线。尽管额定工作隔离电压条件下的预期最短绝缘寿命为 20 年，但是 VDE 增强认证要求工作电压具有额外 20% 的安全裕度，寿命具有额外 50% 的安全裕度，也就是说在工作电压高于额定值 20% 的条件下，所需的最短绝缘寿命为 30 年。

图 9-7 所示为隔离栅在整个寿命期内承受高压应力的固有能力。根据 TDDB 数据，DBQ-16 封装的绝缘耐受能力为 $600V_{RMS}$，寿命为 1000 年，如图 9-7 所示。封装尺寸、污染等级和材料组等因素可能会限制元件的工作电压。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

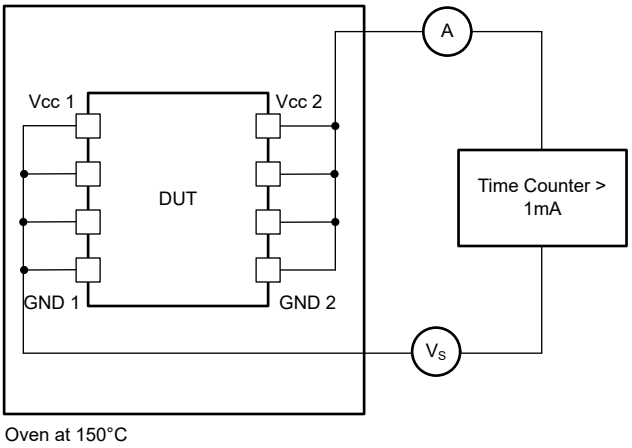


图 9-6. 绝缘寿命测量的测试设置

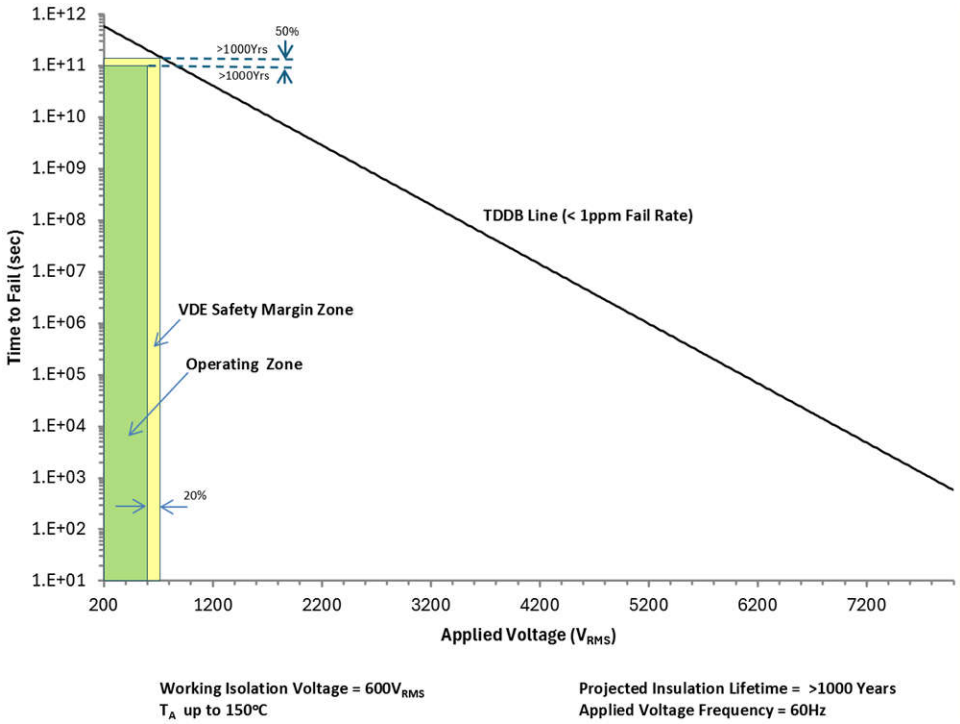


图 9-7. 绝缘寿命预测数据

9.3 电源相关建议

为确保在各种数据速率和电源电压条件下可靠运行，建议将 0.1 μF 旁路电容器放置在输入和输出电源引脚（V_{CC1} 和 V_{CC2}）处。该电容必须尽量靠近电源引脚放置。

9.4 布局

9.4.1 布局指南

至少需要四层才能实现低 EMI PCB 设计（请参阅图 9-8）。层堆叠必须符合以下顺序（从上到下）：高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层。

- 在顶层布置高速走线可避免使用过孔（及其引入的电感），并在隔离器与数据链路的发送器和接收器电路之间实现可靠互连。
- 通过在高速信号层旁边放置一个实心接地层，可以为传输线互连建立受控阻抗，并为返回电流提供出色的低电感路径。
- 靠近接地层放置电源层，会额外产生大约 100pF/inch^2 的高频旁路电容。
- 在底层路由速度较慢的控制信号可实现更高的灵活性，因为这些信号链路通常具有裕量来承受过孔等导致的不连续性。

如果需要额外的电源电压层或信号层，请在堆叠中添加另一个电源层或接地层系统，以使这些层保持对称。这样可使栈保持机械稳定并防止其翘曲。此外，每个电源系统的电源和接地层可以放置得更靠近彼此，从而显著增大高频旁路电容。

有关详细的布局建议，请参阅*数字隔离器设计指南*。

9.4.1.1 PCB 材料

对于运行速度低于 150Mbps（或上升和下降时间大于 1ns）且布线长度达 10 英寸的数字电路板，请使用标准 FR-4 UL94V-0 印刷电路板。该 PCB 在高频下具有较低的电介质损耗、较低的吸湿性、较高的强度和刚度以及自熄性可燃性特征，因而优于较便宜的替代产品。

9.4.2 布局示例

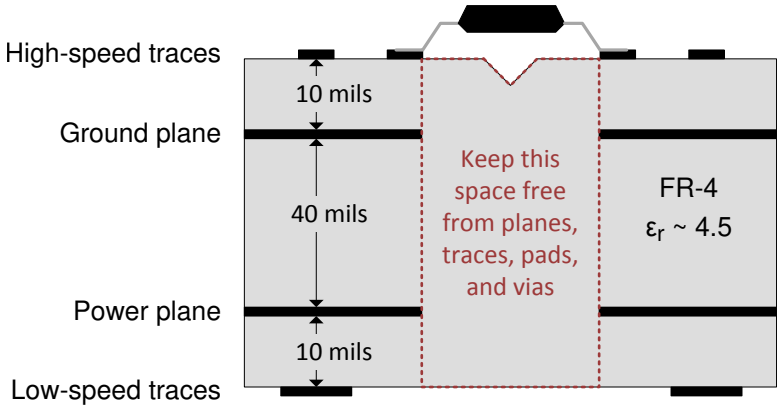


图 9-8. 原理图布局示例

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

10 器件和文档支持

10.1 文档支持

10.1.1 相关文档

如要查看相关文件，请参阅以下内容：

- 德州仪器 (TI)，*采用增强型航天塑料封装且具有待机模式的耐辐射 3.3V CAN 收发器* 数据表
- 德州仪器 (TI)，*采用增强型航天塑料封装的抗辐射加固保障 RS-422 双路差分驱动器和接收器*数据表
- 德州仪器 (TI)，*采用增强型航天塑料的耐辐射 2.2V 至 20V、1A 低噪声可调节输出 LDO* 数据表
- 德州仪器 (TI)，*数字隔离器设计指南*
- 德州仪器 (TI)，*隔离相关术语*
- 德州仪器 (TI)，*如何通过隔离改善工业系统的 ESD、EFT 和浪涌抗扰性* 应用手册

10.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击*通知* 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

10.3 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的使用条款。

10.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
所有商标均为其各自所有者的财产。

10.5 静电放电警告

静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

10.6 术语表

TI 术语表　　本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

11 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (May 2021) to Revision A (August 2026)	Page
• 在整个文档中将传统术语更改为“控制器”	1
• 更新了 V_{IOSM} 值，从 4000 V_{PK} 更新为 5200 V_{PK}，符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准	7
• 更新了键合线寿命降额曲线	17
• 在 *器件功能模式* 中的 *功能表* 添加了表注释	22

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

12 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。如需获取此数据表的浏览器版本，另请参阅左侧的导航栏。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
ISOS141FDBQSEP	Active	Production	SSOP (DBQ) | 16	75 | TUBE	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-55 to 125	141FSE
ISOS141FDBQTSEP	Active	Production	SSOP (DBQ) | 16	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-55 to 125	141FSE
V62/21610-01XE	Active	Production	SSOP (DBQ) | 16	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-55 to 125	141FSE
V62/21610-01XE-T	Active	Production	SSOP (DBQ) | 16	75 | TUBE	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-55 to 125	141FSE

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

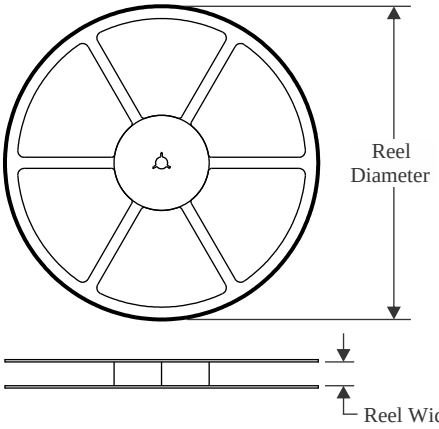
Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

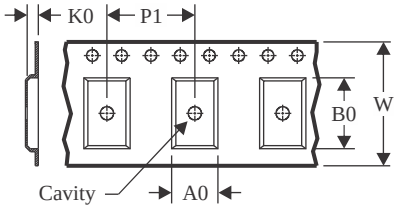
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION

REEL DIMENSIONS

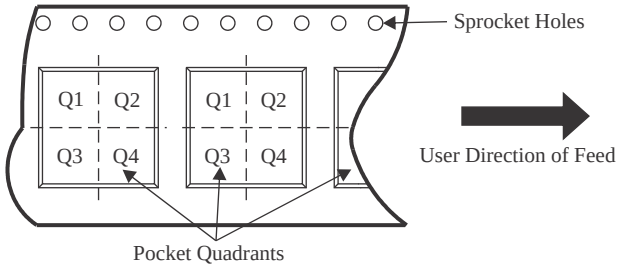


TAPE DIMENSIONS



A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

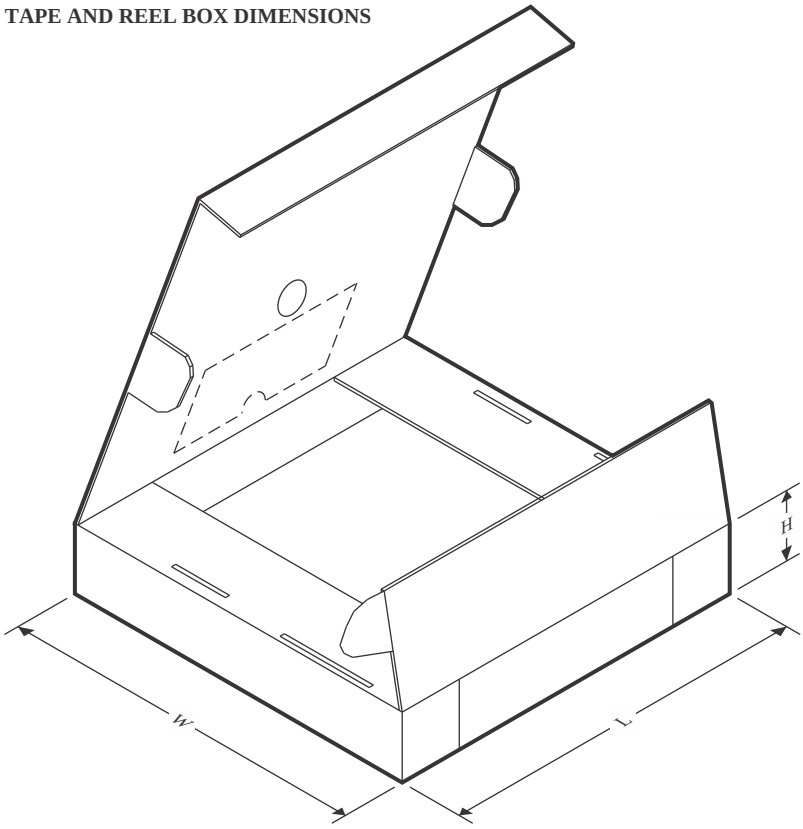
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
ISOS141FDBQTSEP	SSOP	DBQ	16	250	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1

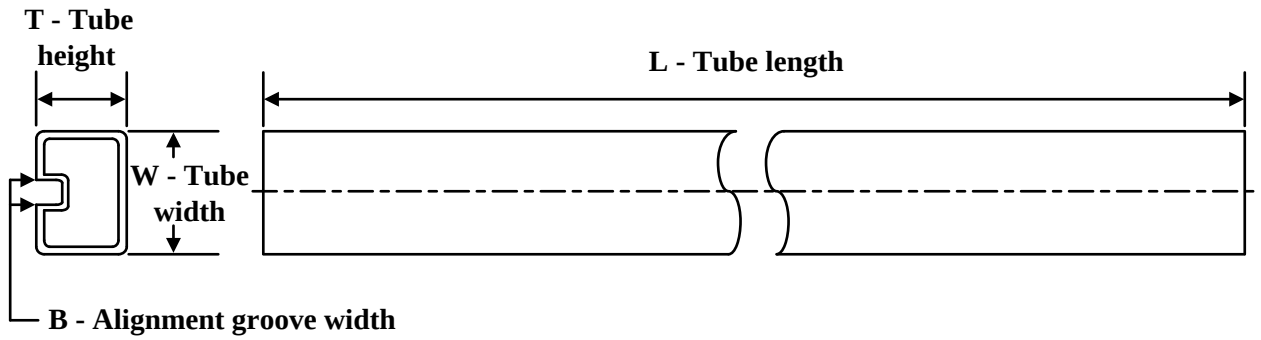
TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

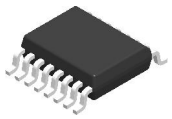
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
ISOS141FDBQTSEP	SSOP	DBQ	16	250	350.0	350.0	43.0

TUBE



*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (µm)	B (mm)
ISOS141FDBQSEP	DBQ	SSOP	16	75	505.46	6.76	3810	4
V62/21610-01XE-T	DBQ	SSOP	16	75	505.46	6.76	3810	4

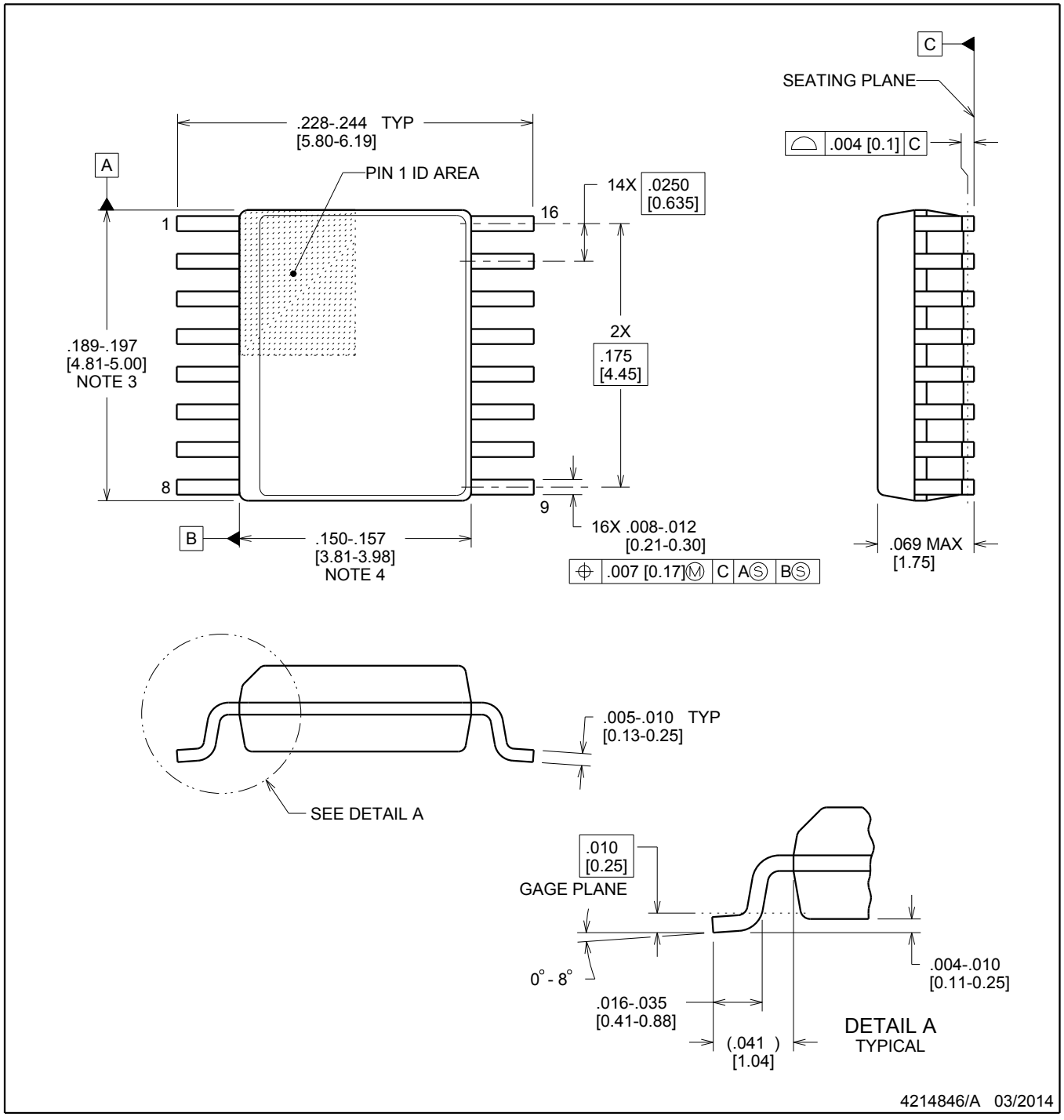


PACKAGE OUTLINE

DBQ0016A

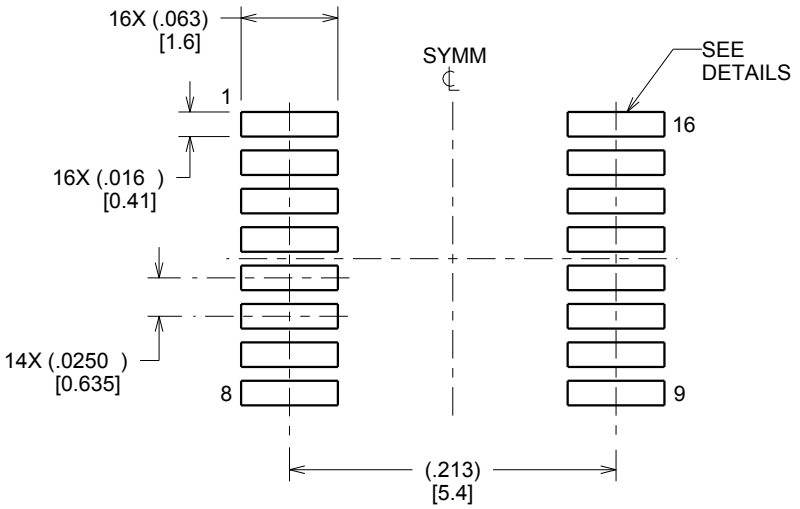
SSOP - 1.75 mm max height

SHRINK SMALL-OUTLINE PACKAGE

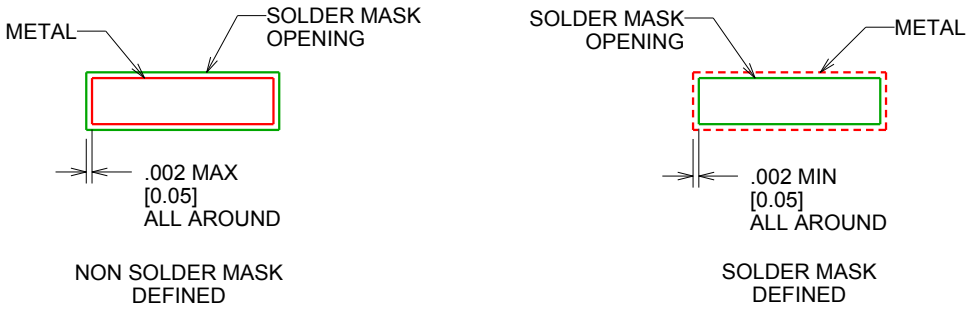


NOTES:

1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed .006 inch, per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MO-137, variation AB.



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4214846/A 03/2014

NOTES: (continued)

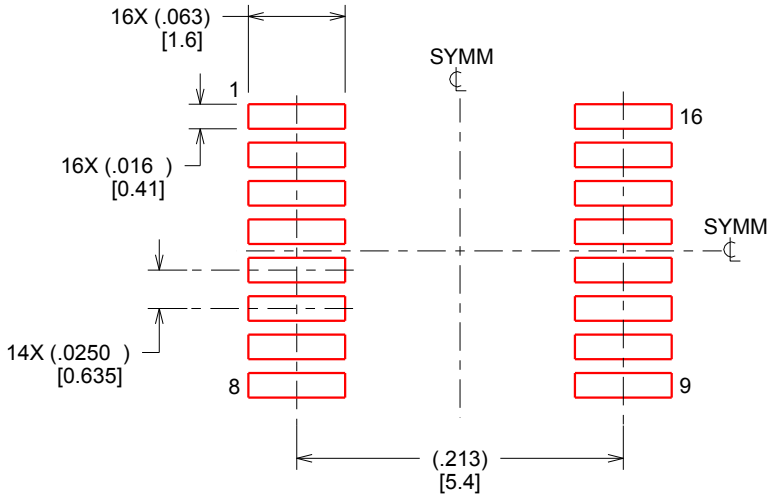
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBQ0016A

SSOP - 1.75 mm max height

SHRINK SMALL-OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON .005 INCH [0.127 MM] THICK STENCIL
SCALE:8X

4214846/A 03/2014

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 销售条款)、TI 通用质量指南 或 ti.com 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。 除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月